УДК 535.37

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТУШЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ BaY_2F_8 , АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ Er^{3+} И Tm^{3+}

В. Н. Махов¹, Т. В. Уварова², М. Кирм³, С. Вильхауэр³

В диапазоне 330–790 К исследовано температурное тушение межконфигурационной 5d-4f люминесценции ионов Er^{3+} и Tm^{3+} в кристалле BaY_2F_8 . Температуры тушения составляют $T_{0.5} \sim 575$ и ~ 550 К для Er^{3+} и Tm^{3+} , соответственно. Показано, что тушение 5d-4f люминесценции ионов Tm^{3+} обусловлено термостимулированной ионизацией 5d электронов в зону проводимости.

Ключевые слова: 5d-4f люминесценция; температурное тушение; Er^{3+} ; Tm^{3+} ; BaY_2F_8 .

Одной из самых важных характеристик любого люминесцентного материала является его температурная стабильность, которая ограничивает возможности применения этого материала при повышенных температурах. В работах [1, 2] была исследована межконфигурационная 5d-4f люминесценция ионов Er^{3+} и Tm^{3+} в хорошо известной фторидной матрице $\mathrm{BaY}_2\mathrm{F}_8$. Однако измерения были выполнены в температурном диапазоне 10–300 K, в котором практически не наблюдалось температурного тушения люминесценции. В данной работе исследована температурная зависимость интенсивности 5d-4f люминесценции ионов Er^{3+} и Tm^{3+} в этой матрице в области высоких температур (330–790 K) и анализируется механизм температурного тушения этой люминесценции. Ионы Er^{3+} и Tm^{3+} испускают 5d-4f люминесценцию в вакуумной УФ (ВУФ) области спектра, и для экспериментального исследования такой люминесценции применялась техника ВУФ спектроскопии с временным разрешением, используя для возбуждения люминесценции синхротронное излучение [3].

 $^{^1}$ ФИАН, 119991 Россия, Москва, Ленинский пр-т, 53; e-mail: makhov@sci.lebedev.ru.

 $^{^2}$ ИОФ РАН, 119991 Россия, Москва, ул. Вавилова, 38.

³ Институт физики, Тартуский университет, Тарту, Эстония.

Эксперимент. Экспериментальные исследования проводились на установке SUPERLUMI [4] в Лаборатории HASYLAB/DESY (Гамбург, Германия), используя для возбуждения люминесценции ВУФ синхротронное излучение от накопительного кольца DORIS. Спектры люминесценции в УФ/ВУФ области спектра регистрировались с помощью монохроматора типа Pouey (спектральное разрешение $\Delta \lambda \sim 2$ нм) и солнечнослепого ФЭУ типа Hamamatsu R6836. Монокристаллы BaY₂F₈, активированные ионами Er³⁺ или Tm³⁺, были выращены методом вертикально направленной кристаллизации (методом Бриджмена) [5].



Рис. 1: Спектры люминесценции BaY_2F_8 :5.0 at% Er^{3+} , измеренные в температурном диапазоне 330–790 K при возбуждении в полосе 4f-5d поглощения, $\lambda = 140$ нм.

Рис. 2: Спектры люминесценции BaY_2F_8 :2.0 at% Tm^{3+} , измеренные в температурном диапазоне 330–780 K при возбуждении в полосе 4f-5d поглощения, $\lambda = 142.5$ нм.

Результаты и обсуждение. Наиболее коротковолновая полоса в спектре люминесценции BaY₂F₈:5.0 at% Er³⁺ при $\lambda = 160.5$ нм (рис. 1), наблюдающаяся только при достаточно низкой температуре и имеющая время распада при комнатной температуре $\tau \sim 25$ нс [2], обусловлена разрешенными по спину $4f^{10}5d-4f^{11}$ переходами с так называемого "низкоспинового" 5d уровня на основной мультиплетный терм ${}^{4}I_{15/2}$ в ионе Er³⁺ [6]. Интенсивная полоса при 168.5 нм, имеющая время распада $\tau \sim 7$ мкс [2], обусловлена запрещенными по спину $4f^{10}5d-4f^{11}$ переходами с нижележащего "высокоспинового" 5d уровня на основной мультиплетный терм ${}^{4}I_{15/2}$ в ионе Er³⁺. Более слабые полосы в районе 175–240 нм соответствуют обоим типам излучательных переходов на возбужденные 4f уровни иона Er³⁺. Повышение температуры приводит к увеличению скорости безызлучательной релаксации с вышележащего "низкоспинового" 5*d* уровня на нижележащий "высокоспиновый" 5*d* уровень и, соответственно, к исчезновению в спектре полос разрешенной по спину люминесценции. Характеристическая температура тушения (T_{0.5}) 5*d*-4*f* люминесценции ионов Er^{3+} в BaY_2F_8 :5.0 at% Er^{3+} , определяемая как температура, при которой интенсивность люминесценции уменьшается до 50% от ее максимальной величины, составляет \approx 575 K.



Рис. 3: Схема энергетических уровней, описывающая механизм температурного тушения 5d-4f люминесценции иона P39 в результате термостимулированной ионизации 5d электронов в зону проводимости кристалла-матрицы.

Наиболее интенсивная полоса в спектре люминесценции BaY₂F₈:2.0 at% Tm³⁺ при 169.5 нм (рис. 2), имеющая время распада $\tau \sim 5$ мкс [2], обусловлена запрещенными по спину $4f^{11}5d-4f^{12}$ переходами в ионе Tm³⁺ с "высокоспинового" 5d уровня на основной мультиплетный терм ³H₆ [6]. Быстрая разрешенная по спину 5d-4f люминесценция ионов Tm³⁺ проявляется в спектре (при комнатной температуре) в виде "плеча" у коротковолнового края основной полосы. В ионе Tm³⁺ энергетическое расстояние между "высокоспиновым" и "низкоспиновым" 5d уровнями меньше, чем в Er³⁺ (на ~600 см⁻¹), что приводит к более низкой интенсивности разрешенной по спину 5d-4f люминесценции. Характеристическая температура тушения 5d-4f люминесценции Tm³⁺ в BaY₂F₈:2.0 at% Tm³⁺ T_{0.5} ≈ 550 K.

Для 5d-4f люминесценции ионов РЗЭ могут быть рассмотрены следующие механизмы температурного тушения: 1) увеличение с температурой вероятности многофононной безызлучательной релаксации на нижележащие 4f уровни; 2) увеличение с температурой концентрационного тушения; 3) термостимулированные безызлучательные переходы через активационный барьер с 5d на 4f уровни; 4) термостимулированная ионизация 5d электронов в зону проводимости кристалла-матрицы (рис. 3).

Для иона Tm^{3+} наиболее высоколежащий 4f уровень (${}^{3}\text{P}_{2}$) расположен при $\sim 38200 \text{ см}^{-1}$ (уровень ${}^{1}\text{S}_{0}$ здесь не рассматривается, поскольку он имеет очень высокую энергию $\sim 75000 \text{ см}^{-1}$). Энергия нижайшего 5d уровня Tm^{3+} в $\text{BaY}_{2}\text{F}_{8}:\text{Tm}^{3+}$, оцененная как энергия фотонов в точке пересечения спектров 4f-5d возбуждения и 5d-4f люминесценции Tm^{3+} , составляет $\sim 59880 \text{ см}^{-1}$, т.е. энергетический зазор между нижним 5d уровнем и уровнем ${}^{3}\text{P}_{2}$ очень велик $\sim 21680 \text{ cm}^{-1}$, что делает невозможным температурное тушение 5d-4f люминесценции Tm^{3+} в результате безызлучательных переходов на 4f уровни (по механизмам 1 или 3). Это проявляется в частности в отсутствие 4f-4f люминесценции ионов Tm^{3+} при возбуждении Tm^{3+} на 4f-5d переходах [7, 8]. Следует отметить также, что благодаря этой специфической системе энергетических уровней иона Tm^{3+} , 5d-4f люминесценция Tm^{3+} практически не претерпевает концентрационного тушения [9]. Таким образом, в случае иона Tm^{3+} только термостимулированная ионизация 5d электронов в зону проводимости (механизм 4) может быть причиной температурного тушения 5d-4f люминесценции.



Рис. 4: Температурные зависимости интенсивностей 5d-4f люминесценции ионов Er^{3+} и Tm^{3+} в матрице BaY_2F_8 . Точки – экспериментальные данные; линии – кривые, полученные при фитировании полученных данных формулой (1).

Исходя из структуры энергетических уровней иона Er^{3+} , можно предположить, что для этого иона механизм 3 может быть основным механизмом температурного тушения 5d-4f люминесценции. Однако повышение температуры не сопровождается появлением достаточно интенсивной 4f-4f люминесценции с нижележащего 4f уровня ${}^{2}\mathrm{F}(2)_{7/2}$. Следует также отметить, что в ионе Er^{3+} возбужденный 4f мультиплет ${}^{2}F(2)_{5/2}$ лежит по энергии близко к нижайшему "низкоспиновому" 5d уровню (выше на ~600 см⁻¹), и релаксация через это 4f состояние может дать дополнительный канал тушения 5d-4fлюминесценции в Er^{3+} . Кроме того, при такой достаточно высокой концентрации Er^{3+} 5.0 at%, существенным становится также концентрационное тушение (механизм 2), которое обычно увеличивается с ростом температуры из-за уширения и, соответственно, большего перекрытия полос поглощения и излучения. Таким образом, механизм температурного тушения 5d-4f люминесценции Er^{3+} может быть более сложным, чем просто ионизация 5d электронов в зону проводимости.

Наблюдаемая температурная зависимость интенсивности 5*d*-4*f* люминесценции (рис. 4) может быть описана хорошо известной формулой для температурного тушения через энергетический барьер (энергию активации):

$$I(T) = \frac{I_0}{1 + A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right)},\tag{1}$$

где I_0 – интенсивность люминесценции при T = 0, A характеризует скорость температурного тушения, k_B – постоянная Больцмана и E_a – энергетический барьер для температурного тушения. Величина E_a , полученная в результате фитирования этой функцией экспериментальной температурной зависимости, дает оценку энергетического барьера для температурного тушения, в частности, через ионизацию 5d электронов в зону проводимости для иона Tm^{3+} , хотя полученная таким способом величина барьера вероятно несколько меньше энергетического расстояния между нижним 5d уровнем иона РЗЭ и дном зоны проводомости [10].

Величина $E_a = 0.39 \pm 0.03$ eV, полученная в результате фитирования для иона Tm³⁺, может быть взята как оценка энергетического зазора между нижним 5d уровнем Tm³⁺ и дном зоны проводимости BaY₂F₈. Используя хорошо известный метод [11], можно рассчитать этот энергетический зазор для всех трехзарядных ионов P3Э в данной матрице, если он известен для одного из них (для Tm³⁺ в данном случае). Для Er³⁺ расчет дает величину этого зазора 0.48 эB, которая заметно превышает значение $E_a = 0.41 \pm 0.02$ eV, полученное из фитирования температурной зависимости интенсивности 5d-4f люминесценции Er³⁺. Этот факт указывает на то, что механизм температурного тушения 5d-4f люминесценции для ионов Er³⁺, по-видимому, более сложный, чем для Tm³⁺, и кроме ионизации 5d электронов в зону проводимости процессы релаксации с участием 4f уровней и, возможно, концентрационное тушение дают дополнительный вклад в температурное тушение 5d-4f люминесценции. В любом случае измерение температурной зависимости интенсивности 5d-4f люминесценции иона Tm³⁺ в какой-либо матрице может использоваться для оценки такого важного для многих применений параметра, как энергетический зазор между нижним 5d уровнем ионов РЗЭ и дном зоны проводимости кристалла-матрицы.

Выводы. В диапазоне 330–790 К исследованы температурные зависимости выхода ВУФ люминесценции, обусловленной межконфигурационными 5d-4f переходами в ионах Er^{3+} и Tm^{3+} в кристалле $\mathrm{BaY}_2\mathrm{F}_8$, и получены температуры тушения этой люминесценции, которые составили $T_{0.5} \sim 575$ и ~550 К для Er^{3+} и Tm^{3+} , соответственно. Для иона Tm^{3+} из-за наличия большого энергетического зазора между излучающим 5d уровнем и нижележащими 4f уровнями, основным механизмом температурного тушения 5d-4f люминесценции является термостимулированная ионизация 5d электронов в зону проводимости кристалла-матрицы. Измерение и последующий анализ температурного тушения 5d-4f люминесценции Tm^{3+} в каком-либо кристалле могут использоваться для оценки энергетического зазора между нижним 5d уровнем всех трехзарядных ионов РЗЭ и дном зоны проводимости в данном кристалле.

Работа была поддержана грантом Министерства образования и науки Российской Федерации № RFMEFI61614X0006, и грантом IUT 2-26 Эстонского Научного Фонда.

ЛИТЕРАТУРА

- V. N. Makhov, N. M. Khaidukov, N. Yu. Kirikova, et al., Nucl. Instrum. and Meth. A 470, 290 (2001).
- [2] J. Becker, J. Y. Gesland, N. Yu. Kirikova, et al., J. Luminescence 78, 91 (1998).
- [3] V. N. Makhov, Physics Scripta 89, 044010 (2014).
- [4] G. Zimmerer, Radiation Measurements 42, 859 (2007).
- [5] Т. В. Уварова, А. А. Пушкарь, В. Н. Молчанов, Известия ВУЗов, Материалы электронной техники 4, 34 (2004).
- [6] R. T. Wegh and A. Meijerink, Phys. Rev. B 60, 10820 (1999).
- [7] V. N. Makhov, N. M. Khaidukov, D. Lo, et al., Optical Materials 27, 1131 (2005).
- [8] M. True, Y. Chen, M. Kirm, S. Vielhauer, and G. Zimmerer, J. Luminescence 124, 279 (2007).
- [9] J. Y. Gesland, N. M. Khaidukov, N. Yu. Kirikova, et al., J. Electron Spectroscopy and Related Phenomena 101-103, 579 (1999).
- [10] P. Dorenbos, J. Phys.: Condens. Matter 17, 8103 (2005).
- [11] P. Dorenbos, J. Phys.: Condens. Matter 15, 8417 (2003).

Поступила в редакцию 19 февраля 2016 г.